



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

H547

对应国外型号
BC547

主要用途

开关和射频放大。

极限值 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

T_{stg} ——贮存温度.....	-55~150
T_j ——结温.....	150
P_C ——集电极耗散功率.....	500mW
V_{CBO} ——集电极—基极电压.....	50V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....	45V
V_{EBO} ——发射极—基极电压.....	6V
I_C ——集电极电流.....	100mA

外形图及引脚排列

TO-92



1—集电极, C
2—基 极, B
3—发射极, E

电参数 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			15	nA	$V_{\text{CB}}=30\text{V}$, $I_{\text{E}}=0$
HFE	直流电流增益	110		800		$V_{\text{CE}}=5\text{V}$, $I_{\text{C}}=2\text{mA}$
$V_{\text{CE(sat)}}$	集电极—发射极饱和电压		0.09	0.25	V	$I_{\text{C}}=10\text{mA}$, $I_{\text{B}}=0.5\text{mA}$
			0.2	0.6	V	$I_{\text{C}}=100\text{mA}$, $I_{\text{B}}=5\text{mA}$
$V_{\text{BE(sat)}}$	基极—发射极饱和电压		0.7		V	$I_{\text{C}}=10\text{mA}$, $I_{\text{B}}=0.5\text{mA}$
			0.9		V	$I_{\text{C}}=100\text{mA}$, $I_{\text{B}}=5\text{mA}$
$V_{\text{BE(on)}}$	基极—发射极导通电压	0.58	0.66	0.7	V	$V_{\text{CE}}=5\text{V}$, $I_{\text{C}}=2\text{mA}$
				0.72	V	$V_{\text{CE}}=5\text{V}$, $I_{\text{C}}=10\text{mA}$
f_T	特征频率		300		MHZ	$V_{\text{CE}}=5\text{V}$, $I_{\text{C}}=10\text{mA}$, $f=100\text{MHZ}$
NF	噪声系数		2	10	dB	$V_{\text{CE}}=5\text{V}$, $I_{\text{C}}=200\mu\text{A}$ $f=1\text{KHZ}$, $R_g=2\text{K}\Omega$

分档及其标志

A

B

C

110—220

200—450

420—800